



	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP048N12N3GXKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 120V 100A TO220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP048N12N3GXKSA1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP048N12N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 100A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 230µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	IPP048N12N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12000pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	182nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 120V 100A (Tc) 300W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPP048N12N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP048N12N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP048N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP048N12N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP04N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-220AB</p>	 <p>IPP048N06LG(048N06L) INFINEON IPP048N06LG(048N06L) INFINEON</p>	 <p>IPP04CN10N G INFINEON IPP04CN10N G INFINEON</p>	 <p>IPP048N12N3 G Infineon Technologies IPP048N12N3 G Infineon Technologies</p>
 <p>IPP048N06LG I IPP048N06LG I</p>	 <p>IPP048N12N3G INF IPP048N12N3G INF</p>	 <p>IPP04CN10NGXKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPP04CN10NG Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP048N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP048N12N3GXKSA1 Datenblatt	IPP048N12N3GXKSA1-Datenblätter	IPP048N12N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP048N12N3GXKSA1
IPP048N12N3GXKSA1 Electronic	IPP048N12N3GXKSA1-Komponenten	IPP048N12N3GXKSA1-Verteiler	IPP048N12N3GXKSA1-Bild	IPP048N12N3GXKSA1-Teil
IPP048N12N3GXKSA1 Preis	IPP048N12N3GXKSA1 Hersteller	IPP048N12N3GXKSA1 Bild	IPP048N12N3GXKSA1 Aktie	IPP048N12N3GXKSA1 Inventar
IPP048N12N3GXKSA1 Neu	IPP048N12N3GXKSA1 Original	IPP048N12N3GXKSA1 garantiert	IPP048N12N3GXKSA1 RFQ	IPP048N12N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited